

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏

幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也

日時 10月26日(水) 14:00~16:50

27日(木) 10:00~14:40

会場 東北大学未来情報産業研究館5F(仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-10. 地下鉄東西線:青葉山駅から徒歩1分.

TEL [022] 795-4833 黒田理人)

議題 プロセス科学と新プロセス技術

26日

1. [招待講演] 最先端LSIプロセスにおける重金属汚染の制御 嵯峨幸一郎(ソニー)
2. 高濃度ドーピングされた(100)方位SOIウェーハ上に対するSi選択エピタキシャル成長後の平坦な表面形成技術
○古川貴一・寺本章伸・黒田理人・諏訪智之・橋本圭市・須川成利(東北大)・鈴木大介・千葉洋一郎・石井勝利・清水 亮・長谷部一秀(東京エレクトロン東北)
3. [招待講演] 超低電圧0.4V動作SOTB-CMOS回路のダイ間遅延ばらつきを抑制する基板バイアス制御技術
○横山秀樹・山本芳樹・尾田秀一・蒲原史朗(ルネサス エレクトロニクス)・杉井信之(日立)・石橋孝一郎(電通大)・水谷朋子・平本俊郎(東大)・山口泰男(ルネサス エレクトロニクス)
4. [招待講演] 基板バイアス技術を用いたSOTB 2Mbit SRAMの超低電圧動作
○山本芳樹・横山秀樹・長谷川拓実・岡西 忍・前川径一・新川田裕樹・蒲原史朗・山口泰男(ルネサス エレクトロニクス)・水谷朋子・平本俊郎(東大)

平成27年度SDM研究専門委員会若手優秀発表賞 表彰式

27日

1. 原子層堆積法で成膜した Al_2O_3 膜界面に及ぼす酸化種の影響
○齋藤雅也・諏訪智之・寺本章伸・黒田理人・幸田安真・杉田久哉・石井秀和・志波良信・白井泰雪・須川成利(東北大)・林 真里恵・土本淳一(キャノンアネルバ)
2. ボトムコンタクト型OFETにおけるペンタセン薄膜形成に関する検討
○前田康貴・廣木瑞葉・大見俊一郎(東工大)
3. 動作電圧変化時の過渡状態におけるランダムテレグラフノイズの挙動に関する研究
○間脇武蔵・寺本章伸・黒田理人・市野真也・後藤哲也・諏訪智之・須川成利(東北大)
4. Si基板表面平坦化によるHf系MONOS構造の電気特性向上に関する検討 ○工藤聡也・大見俊一郎(東工大)
5. [招待講演] Novel Pixel Structure with Stacked Deep Photodiode to Achieve High NIR Sensitivity and High MTF
○Hiroki Takahashi・Hiroshi Tanaka・Masahiro Oda・Mitsuyoshi Ando・Naoto Niisoe(TPSCO)・Shinichi Kawai・Takuya Asano・Mitsugu Yoshita・Tohru Yamada(PSCS)
6. [招待講演] 科学計測用CMOSイメージセンサのための低ノイズイメージングテクニック
○徐 珉雄・川人祥二(静岡大)

☆SDM研究会今後の予定 []内発表申込締切日

11月10日(木), 11日(金) 機械振興会館[締切済] テーマ:プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般

【問合せ先】

黒田理人(東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp